PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-305915

(43)Date of publication of application: 28.10.1992

(51)Int.CI.

H01L 21/027 G03F 7/20

(21)Application number : 03-094867

(71)Applicant: NIKON CORP

(22)Date of filing:

02.04.1991

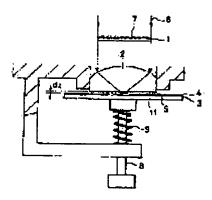
(72)Inventor: OZEKI HISAO

MATSUBARA TAKASHI

(54) ADHESION TYPE EXPOSURE DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To make thin the film thickness of an immersion liquid interposed between a photo-mask or an optical projection system and a wafer and reduce the quantity of light absorbed, and to minimize and prevent exposure unevenness in an adhesion type exposure device. CONSTITUTION: A wafer 3 coated with a photoresist 4 is fast stuck on an exposure lens 2 through an immersion liquid 5. A surface-active agent 11 is mixed into the immersion liquid 5 within a range that the photoresist 4 is not affected, and the surface-active agent 11 reduces the surface tension of the immersion liquid 5, and improves wettability. Accordingly, the film thickness d2 of the immersion liquid is made thinner than the case where surface-active agent is not mixed.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出頭公開番号

特開平4-305915

(43)公問日 平成4年(1582)10月28日

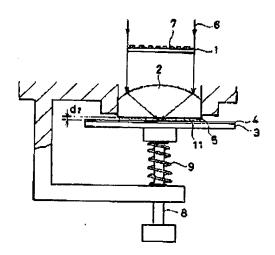
(51) Int CL ⁵ H 0 1 L 21/027	織則配号	庁内整理番号 7818-2H 7352-4M	F J		技術表示管所	
G03F 7/20	5 2 1		HOIL	21/30	311	A
			:	審查請求	未翻求一篇求項	の数1(全 3 頁)
(21)出顯論号	特票平3~84867	-	(71)出願人		_	
(22)出題日	平成3年(1991)4	F 2 B			代田区丸の内3	丁目2番3号
			(72) 発明者	東京都品		目6番3号 株式
			(72) 発明者	東京都品	=	目6番3号 株式
			(74)代理人			

(54) 【発明の名称】 密着型電光接置

(57) 【臺約】

【目的】 密着型爾光義音において、フォトマスクまた は投影光学系とウエハとの間に介在される浸液の模型を 静くして光の吸収量を少なくし、露光ムラを経済防止す ることを目的とする。

【構成】 フォトレジスト4を塗布されたウエハ3を露 光レンズ2に長級5を介して密着させる。 授終5にはフォトレジスト4に影響を与えない範囲で界面活性剤11 が混入されており、界面摘性類11は、浸液5の表面張力を減らし、溢れ性を高める。したがって、浸液の膜厚 dz は界面活性剤を混入しない場合より薄くなる。



(2)

特開平4-305915

【特許請求の範囲】

【餅求項1】 フォトレジストを整布されたウエハを投 影光学系もしくはフォトマスクに浸液を介して密着さ せ、原射光の原射によりフォトマスクのバターンを前記 フォトレジストに転写するようにした密着型電光装置に おいて、前配浸液は前記フォトレジストに影響を与えな い範囲で昇面消性剤が混入されていることを特徴とする 密着効電光装置。

1

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分別】本発明は、LSIの製造工程において、フォトマスク上のパターンをウエハ上に投影器光する解光装置、特に密着型露光装置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】レーザー光等を展射しフォトマスク上の
パターンを投影光学系によってシリコンウエハ等の半導
体基板上に投影器光するこの種の露光美麗における庭光
方式としては、①密着(コンタクト)の光方式、②プロ
キシミティ蘇光方式、③反射型投影越光方式、④棉小レ 20
ンズ投影露光方式の4方式が知られている。

【0003】このうち密着展光方式は、フォトマスク(または没影光学系)とウエハとを密着させて観光するもので、これらが完全に審着している場合には、フォトレジスト中の波長が周折率分の1に短くなるため、回折の影響が少なく、高解像度の転写が得られるという特色を有している。この密着は真空吸着、静電チャック等によって行っている。しかし、完全な密着を実現することは極めて難しく、またフォトマスクとウエハとを機械的に接触させているためにウエハ表面の突起等によりフォルマスクに欠陥が全じ、その寿命を低下させると同時にデバイスの冷留りに影響を及ばすといった問題があった。

【0004】そこで、密若爾光方式によるこのような問 題を解決する方法としてフォトマスクとウェハ間に液体 (侵渡)を充填している。図2はウエハを浸液を介して 役影光学系に密若させた場合を示すもので、1はフェト マスク、2は投影光学系の一部を構成する蘇光レンズ、 3はフォトレジスト4が釜布されたウエハ、5は露光レ ンズ2とウエハ3間に充塡された没絃、6はフォトマス 40 ク1のパターン?を照射しフォトレジスト4を観光する 照射光、8はウエハ3を保持する保持体、9は保持体8 を上方に付券しウエハ3を露光レンズ2に所定圧にて押 し付ける圧縮コイルばねである。限射光6の波長は短い ほど回折の影響が少なく、そのため光源としてエキシマ レーザー等のレーザー装置が用いられる。 没被5として は、屈折率がフォトレジスト4と同程度で光の吸収が少 なく、しかもフォトレジスト4を密かさないものが望ま しく、週常純水が使用される。

[0005]

【発明が解決しようとする謎題】しかしながら、上途したような浸液5を使用した密着型盤光装器においては、 浸統5自身の膜厚ムラがあると、浸液5による照射光6の吸収量にムラが生じるため、コンタクト農光されたフォトレジスト4のパターンが的確に顔光されている部分とそうでない部分とが生じてしまうという問題があっ

とそうでない部分とが生じてしまうという問題があった。したがって、このような露光ムラの発生を防止するため、浸液5の濡れ性を高めて表面張力を下げ、膜厚d を整力薄くすることが望まれている。

3 【0006】本発明は上述したような従来の問題点および受望に鑑みてなされたもので、その目的とするところは、没被の原厚を葬くし、没被による選光ムラを軽減防止し得るようにした密着型露光装置を提供することにある。

[0007]

【課題を祭袂するための学校】本発明は上記目的を達成するため、フォトレジストを塗布されたウエハを投影光学系もしくはフォトマスクに浸液を介して密着させ、展射光の限射によりフォトマスクのパターンを前紀フォトレジストに転写するようにした密着型露光装置において、前記浸液は前記フォトレジストに影響を与えない範囲で界面活性新が混入されているものである。

[0008]

【作用】本発明において界面活性剤は複液の濡れ性を高め、表面張力を下げる。したがって浸渍の膜厚を薄くする。

[0009]

【実施例】以下、本発明を図面に示す実施例に基づいて 詳細に説明する。図1は本発明に係る密着型解光装置の 一実施例を示す要部の断面図である。なお、図中図2と 同一義成部量のものに対しては同一符号を以て示し、そ の説明を信略する。

【0010】本実施例は投影光学系にウエハを密着させた場合を示すもので、フォトマスク投影光学系の一部を構成する超光レンズ2とウエハ3との間に介任される網水等の授液5に界面話性剤11を提入したものである。

【0011】界面活性剤11としては、陽イオン性、陰イオン性、非イオン性等種々のものが使用可能であるが、風折率が浸液5と同程度で光の吸収が少なく、またフォトレジスト4を滞かしたりすることのない範囲で避入されることが留ましい。特に、陽イオン性のうち四級アンモニウム塩系は、温れ性も高く、レジストへの影響も少なく、光の吸収も少ないため好ましい。

【0012】かくしてこのような無政においては界面活性別11が浸液5の表面優力を減らして濡れ性を高めるため、ウエハ3を所定圧力にて露光レンズ2に圧接した際、浸液5の膜厚d2を図2に示した従来装置と比較して舞くする(d2くd1)ことができ、また膜厚が薄くなれば光の吸収量も少なくなるので、これに比例して光50の吸収ムラが減少し、霧光ムラを軽減防止することがで

—86—

(3)

特開平4-305915

きるものである.

[0013]

【発明の効果】以上説明したように本発明に係る密者型 魔光装置によれば、侵蔽に界面活性剤を混入することに より、侵被自身の表面張力を減らして濡れ性を向上させ るようにしたので、侵被の襲撃を導くすることができ る。したがって、長被の膜厚ムラが小さく、光の吸収を 少なくすることができ、浸椒による露光ムラを軽減防止 することができる。

3

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る密着型露光装置の一実施例を示す 要都の断面図である。

【図2】密着型無光弦像の従来例を示す更部の断面図で ある。

【符号の説明】

- 1 フォトマスク
- 2 鑑光レンズ
- ウエハ
- 4 フォトレジスト
- 5 浸液
- 6 照射光
- 10 7 マスク
 - 11 界面報任利

